

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2001年3月8日 (08.03.2001)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 01/15860 A1

(51) 国際特許分類: B24B 37/00, H01L 21/304

(21) 国際出願番号: PCT/JP00/05595

(22) 国際出願日: 2000年8月21日 (21.08.2000)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願平11/246243 1999年8月31日 (31.08.1999) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 信越半
導体株式会社 (SHIN-ETSU HANDOTAI CO., LTD.)
[JP/JP]: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目4番2
号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 小林 誠
(KOBAYASHI, Makoto) [JP/JP]. 高松 広行 (TAKA-
MATSU, Hiroyuki) [JP/JP]: 〒961-8061 福島県西白河
郡西郷村大字小田倉字大平 150番地 信越半導体株式
会社 半導体白河研究所内 Fukushima (JP).

(74) 代理人: 好宮幹夫 (YOSHIMIYA, Mikio); 〒111-0041
東京都台東区元浅草2丁目6番4号 上野三生ビル4F
Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): JP, KR, US.

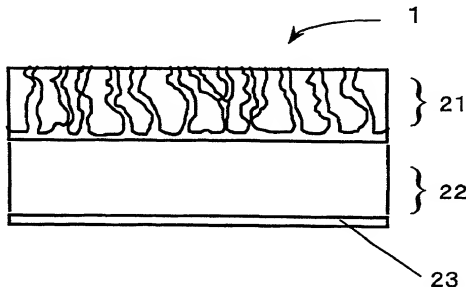
(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE,
DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

[続葉有]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR POLISHING SEMICONDUCTOR WAFER

(54) 発明の名称: 半導体ウエーハ用研磨布及び研磨方法



(57) Abstract: A polishing cloth is used to polish a semiconductor wafer, particularly to give a mirror finish, without causing damage to the wafer surface. The polishing cloth has a zinc compound content of less than 200 ppm in terms of the weight of zinc in the polishing cloth, preferably less than 100 ppm, and more preferably no zinc compound is contained. The polishing cloth (1) includes a base layer (22), preferably of unwoven cloth, and a porous surface layer (21), preferably of polyurethane foam. The zinc compound content in the surface layer (21) is less than 100 ppm in terms of the weight of zinc in the surface layer (21).

[続葉有]